

# ÍNDICE GENERAL

|  |           |
|--|-----------|
| PRESENTACIÓN .....   | 11        |
| <b>PARTE I. DESCRIPCIÓN DE LOS MICROACELERÓMETROS .....</b>                  | <b>13</b> |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LOS MICROACELERÓMETROS .....</b>                           | <b>15</b> |
| Introducción.....  | 15        |
| Función de transferencia.....  | 15        |
| Función de transferencia mecánica .....                                      | 15        |
| Función de transferencia mecánico-eléctrica .....                            | 19        |
| Función de transferencia eléctrica.....                                      | 20        |
| Tecnologías microelectrónicas de fabricación.....                            | 21        |
| Áreas de aplicación.....   | 23        |
| <b>MICROACELERÓMETROS PIEZORRESISTIVOS BASADOS EN TECNOLOGÍA BESOI .....</b> | <b>25</b> |
| Elemento sensor (Puente de Wheatstone) .....                                 | 25        |
| Descripción de la tecnología de acelerómetros BESOI.....                     | 27        |
| Diseños .....  | 28        |
| Tipo voladizo (AC2-d2) .....   | 28        |
| Tipo voladizo con sistema de autotest (AC2-d2U) .....                        | 32        |
| Acelerómetro de 5 Puentes ( <i>Twin-mass</i> ) (AC2-d5).....                 | 38        |
| Acelerómetro Triaxial de 6 puentes (AC2-posi) .....                          | 41        |
| Comparación entre los diseños .....  | 49        |
| Referencias .....  | 50        |
| <b>PARTE II. DIARIO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN .....</b>                     | <b>53</b> |
| <b>DIARIO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN.....</b>                                | <b>55</b> |
| Introducción.....  | 55        |
| La Sala Blanca del CNM.....  | 56        |
| Áreas de trabajo.....  | 58        |
| Visita a la Sala Blanca.....   | 59        |
| Definición del proceso de fabricación .....                                  | 62        |
| Procesado de la oblea de silicio BESOI.....                                  | 63        |
| Procesado de la oblea de vidrio.....   | 65        |
| El dispositivo final .....   | 67        |
| <b>DIARIO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN. OBLEAS DE SILICIO.....</b>             | <b>69</b> |
| Primer día .....   | 69        |

|  |    |
|--|----|
| 1. Marcar y preparar obleas.....   | 69 |
| Substratos de partida .....  | 69 |
| Medida del óxido de silicio de la cara posterior .....                   | 71 |
| Decapado del óxido de silicio de la cara posterior .....                 | 71 |
| Limpieza de las obleas .....   | 72 |
| 2. Fotolitografía para el alineamiento de doble cara .....               | 72 |
| Segundo día .....  | 74 |
| 2. Fotolitografía para el alineamiento de doble cara (continuación)..... | 74 |
| Grabado seco del silicio .....   | 74 |
| Decapado de la resina .....  | 75 |
| 3. Preparación para el grabado anisótropo .....                          | 76 |
| Limpieza de las obleas .....   | 76 |
| Oxidación térmica.....   | 77 |
| Tercer día .....   | 78 |
| 3. Preparación para el grabado anisótropo (continuación).....            | 79 |
| Medida del óxido de silicio crecido .....                                | 79 |
| Limpieza de las obleas .....   | 79 |
| Depósito de nitruro de silicio LPCVD.....                                | 79 |
| Fotolitografía: definición de ventanas para el grabado anisótropo .....  | 80 |
| Cuarto día .....   | 81 |
| 3. Preparación para el grabado anisótropo (continuación).....            | 81 |
| Grabado seco del nitruro de silicio en el dorso de la oblea .....        | 82 |
| Decapado del nitruro de silicio en la cara componentes.....              | 82 |
| Decapado de la resina .....  | 82 |
| Limpieza general.....  | 83 |
| Quinto día .....   | 83 |
| 4. Definición de las piezoresistencias .....                             | 83 |
| Fotolitografía de doble cara .....                                       | 84 |
| Preparación para el grabado húmedo del óxido térmico .....               | 86 |
| Grabado húmedo del óxido térmico de 6.000Å .....                         | 86 |
| Sexto día .....  | 87 |
| 4. Definición de las piezoresistencias (continuación).....               | 87 |
| Marcas en el silicio para facilitar el alineamiento posterior .....      | 87 |
| Grabado seco de silicio en el RIE.....                                   | 87 |
| Decapado de la resina .....  | 88 |
| Limpieza simple.....   | 89 |
| Oxidación para proteger el silicio durante la implantación .....         | 89 |
| Séptimo día.....   | 89 |
| 4. Definición de las piezoresistencias (continuación).....               | 90 |
| Implantación iónica de boro.....   | 90 |
| Decapado del óxido de silicio .....                                      | 92 |
| Limpieza simple .....  | 92 |
| Oxidación para activar las impurezas .....                               | 92 |
| Octavo día.....  | 93 |
| 5. Apertura de contactos.....  | 93 |

|   |     |
|---|-----|
| Limpieza simple .....                                     | 93  |
| Depósito de óxido de silicio PECVD .....                  | 93  |
| Fotolitografía para la apertura de contactos .....        | 94  |
| Grabado húmedo del óxido de silicio .....                 | 95  |
| Decapado de la resina .....                               | 95  |
| Noveno día.....   | 97  |
| 6. Metalización .....                                     | 97  |
| Preparación para la metalización .....                    | 97  |
| Metalización.....   | 97  |
| Fotolitografía para definir las pistas de metal .....     | 99  |
| Grabado del aluminio.....                                 | 101 |
| Decapado de la resina .....                               | 102 |
| Décimo día .....  | 102 |
| 6. Metalización (continuación).....                       | 102 |
| Limpieza en agua desionizada .....                        | 102 |
| Recocido del aluminio .....                               | 103 |
| 7. Preparación para el grabado seco del silicio .....     | 104 |
| Fotolitografía para definir el grabado por RIE.....       | 104 |
| Undécimo-duodécimo día .....                              | 108 |
| 8. Grabado anisótropo .....                               | 108 |
| Micromecanización en volumen .....                        | 108 |
| Undercutting .....  | 110 |
| Paro del ataque .....                                     | 111 |
| Grabado anisótropo de la oblea de acelerómetros.....      | 112 |
| Decimotercer día .....                                    | 116 |
| 8. Grabado anisótropo (continuación).....                 | 117 |
| Limpieza en HCl .....                                     | 117 |
| Decapado seco del nitruro de silicio del dorso .....      | 117 |
| 9. Micromecanización superficial .....                    | 117 |
| Grabado del óxido de silicio enterrado .....              | 118 |
| Micromecanización en superficie .....                     | 118 |
| Decimocuarto día.....                                     | 122 |
| 10. Grabado seco profundo del silicio.....                | 122 |
| Grabado seco profundo del silicio .....                   | 122 |
| Decapado de la resina .....                               | 124 |
| RIE del óxido de silicio del borde de la oblea .....      | 125 |
| Final de fabricación de las obleas de silicio.....        | 125 |
| Decimoquinto día .....                                    | 125 |
| 11. Inspección de las obleas .....                        | 125 |
| Inspección a simple vista .....                           | 125 |
| Inspección en el microscopio electrónico SEM.....         | 127 |
| DIARIO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN. OBLEAS DE VIDRIO ..... | 133 |
| Primer día .....  | 133 |
| 1. Preparación de una máscara de silicio.....             | 134 |
| Segundo día .....   | 134 |

|  |     |
|--|-----|
| 1. Preparación de una máscara de silicio (continuación) .....          | 134 |
| Fotolitografía para definir la máscara .....                           | 135 |
| Mejora de la adherencia de la resina.....                              | 135 |
| Grabado del óxido de silicio térmico .....                             | 135 |
| Decapado de la resina .....  | 135 |
| Tercer día .....   | 136 |
| 1. Preparación de una máscara de silicio (continuación) .....          | 136 |
| Grabado anisótropo de las obleas .....                                 | 136 |
| Cuarto día .....   | 138 |
| 1. Preparación de una máscara de silicio (continuación) .....          | 138 |
| Decapado del óxido térmico .....                                       | 138 |
| 2. Soldadura anódica .....   | 139 |
| Técnicas de soldadura .....  | 139 |
| Soldadura anódica de la máscara de silicio a una oblea de vidrio ..... | 141 |
| Quinto-Octavo día .....  | 143 |
| 3. Grabado del vidrio. Grabado de la máscara de silicio.....           | 143 |
| Grabado del vidrio .....   | 143 |
| Grabado de la máscara de silicio .....                                 | 144 |
| Final de obleas de vidrio.....   | 145 |
| DIARIO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN.                                     |     |
| DISPOSITIVOS ACABADOS .....  | 147 |
| Decimosexto día .....  | 147 |
| 12. Soldadura anódica silicio-vidrio .....                             | 147 |
| 13. Inspección de los dispositivos en un microscopio óptico.....       | 147 |
| Decimoséptimo día.....   | 151 |
| 14. Serrado de las obleas .....  | 151 |
| 15. Final del proceso de fabricación.....                              | 152 |
| ANEXO I. RELACIÓN DE VÍDEOS INCLUIDOS EN EL DVD .....                  | 153 |